



炭化ケイ素および関連材料に関する世界最大級の国際会議 「ICSCRM 2026」に工学部教員が参加

関西学院大学
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY

一次世代パワー半導体材料に関する研究成果を世界へ発信—

報 道 各 位

関西学院広報部

関西学院大学（兵庫県西宮市、学長：森康俊）工学部の大谷昇教授、金子忠昭教授が、2026 年 9 月 27 日（日）から 10 月 2 日（金）にかけ、パシフィコ横浜ノースにて開催される ICSCRM 2026（International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2026 / シリコンカーバイドおよび関連材料に関する国際会議 2026）に参加いたします。

関西学院大学は、次世代パワー半導体材料である炭化ケイ素（シリコンカーバイド、SiC）の研究を推進しています。SiC は従来のシリコン半導体に比べて低損失かつ高耐圧な特性を有し、電気自動車や再生可能エネルギー、AI データセンターなどの分野で求められる高度な電力制御を実現する材料として注目されています。世界的に電力需要が増加する中、省エネルギー化や脱炭素社会の実現、さらには電力インフラの高度化を支える重要な基盤材料として期待されています。

ICSCRM は、SiC および関連材料に関する研究者・技術者が世界中から集う国際会議として 1987 年から開催されており、これまで、材料開発からデバイス応用まで最先端の研究成果が発表されてきました。

関西学院大学は、ICSCRM 2026 で研究成果を発表するとともに、産学連携を通じた社会実装への取組みについても、世界へ発信します。

ICSCRM 2026 概要

期間：2026 年 9 月 27 日（日）～10 月 2 日（金）

※9 月 27 日（日）：チュートリアル

9 月 28 日（月）～10 月 2 日（金）：技術プログラム・展示会

場所：パシフィコ横浜ノース

（神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）

規模：参加者見込み 約 1,500 名（国内 900 名、海外 600 名）

展示募集小間 247 小間

H P : <https://icscrm2026.org/>

関西学院大学による発表概要

<招待講演>

日 時：9 月 29 日（火） 10 時 40 分～11 時 10 分

発表者：大谷 昇 教授

演 題：Interactions between point defects/impurities and extended defects during 4H-SiC crystal growth

（4H-SiC 結晶成長における点欠陥/不純物と拡張欠陥の相互作用）

※英語による講演

<研究発表>

日 時：9 月 28 日（月）～10 月 2 日（金）

内 容：

【大谷 昇 教授】

物理気相輸送法によって成長させた 4H-SiC 結晶の各種表面特性など、大谷研究室から 4 件の研究成果を発表予定。

【金子忠昭 教授】

SiC 結晶の特性評価や製造プロセスの高度化、高品質結晶開発、独自の「Dynamic AGE-ing®」技術の発展など、金子研究室から 5 件の研究成果を発表予定。

※金子教授が CTO を務める QureDA Research 株式会社 (<https://www.quireda-research.com/>) との共同発表となります。

研究者紹介

大谷 昇（おおたに・のぼる）教授

関西学院大学工学部教授。専門分野は半導体材料、欠陥物理、結晶成長であり、SiC 単結晶、結晶欠陥の研究に取り組む。

2008 年～2017 年：本学 SiC 材料・プロセス研究開発センター長

ICSCRM 2026 では組織委員会の副委員長を務める。

<https://www.kg-nanotech.jp/professor.php?mode=detail&code=9>

金子忠昭（かねこ・ただあき）教授

関西学院大学工学部教授。次世代パワー半導体材料である SiC の結晶成長技術や高品質結晶の開発を専門とする。

2017 年～現在：本学グリーンモビリティ材料開発プロジェクトリーダー

産学連携による研究成果の社会実装を積極的に推進している。

<https://www.kg-nanotech.jp/professor.php?mode=detail&code=5>

本件に関するお問い合わせ先：学校法人関西学院 広報部企画広報課（担当：中谷、和田）

兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155 〒662-8501 TEL. 0798-54-6873 Fax. 050-3535-4985